

[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl<sup>6</sup>

G03F 1/14

H01L 21/00



# [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95113199.0

[43]公开日 1998年6月3日

[11] 公开号 CN 1183579A

[22]申请日 95.12.28

[30]优先权

[32]94.12.28[33]JP[31]327512/94

[71]申请人 日本电气株式会社

地址 日本东京都

[72]发明人 佐仓直喜

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

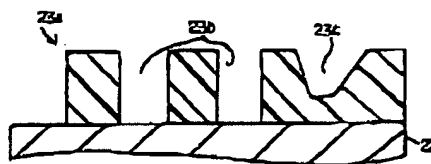
代理人 萧海昌 邹光新

权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图页数 9 页

[54]发明名称 用由假图形所形成的光刻胶掩模将层精确构图成目标图形的方法

[57]摘要

由于显影后烘烤中的收缩而使光刻胶掩模(23a)的表面中出现张力,而形成于光刻胶掩模中的粘附力(23c)吸收了该张力,因而保持对半导体衬底(22)粘附力,防止了光刻胶图形出现不希望的变形。



(BJ)第 1456 号